KTN 高速光スキャナの光路長制御による偏向角増大

Increase in scanning angle by controlling optical length of KTN-based scanner

饗場悠太2 上野雅浩1 佐々木雄三1 坂本尊1 小林潤也1

○豊田誠治1 阪本匡1 [©]Seiji Toyoda Yuta Aiba Masahiro Ueno Yuzo Sasaki Takashi Sakamoto Junya Kobayashi Tadashi Sakamoto

> 1日本電信電話株式会社 NTT デバイスイノベーションセンタ NTT Device Innovation Center, NTT Corporation

2 東京工業大学院 理工学研究科

Department of Physics, Tokyo Instutute of Technology

E-mail:toyoda.seiji@lab.ntt.co.jp

1. 緒言

優れた電気光学効果を有する KTa_{1-v}Nb_vO₃(KTN)結晶を用い た光スキャナは、ガルバノミラーなどの機械駆動型光スキャナよ り高速な光スキャナとして注目されている。我々はこれまで KTN 光スキャナの特性向上を行い、チップ小型化による高速化、タ ンデム接合による偏波無依存化、光路折り返し構成による偏向 角広角化を実現し、応用領域を拡大してきた。応用例の一つと して、200 kHz の掃引速度を有する広帯域波長掃引光源を実 現し、3 次元生体イメージング用光源(OCT 光源)として実用化 された[1]。OCT システムにおいては、測定深達度と空間分解 能を同時に満足する必要があり、広角な偏向角を有する KTN 光スキャナの実現が要求される。最初 DC を印加し注入された 電荷に起因した電界形成する残留屈折率分布に対し AC を印 加し偏向動作が実現され、偏向角は下式で近似できる[2]。

$$\theta = -n_0^3 g_{11} \rho L \varepsilon \frac{V}{d} \tag{1}$$

 $(n_0:$ 電圧印加前屈折率、L:光路長、 $g_{11}:$ 電気光学定数、 ε :誘電 率、 ρ :残留電荷、V:印加電圧、d:結晶厚)

式1は近軸近似が成り立つ前提で導出したものであるが、今回、 より詳細な光学モデルに基き、光路長を制御した KTN 光スキャ ナの偏向角を評価したので報告する。

2. 偏向モデル

図1(a)に KTN 光スキャナの構造を示す。結晶厚方向(以後x 軸)にDC電圧を印加した後の残留電荷はxに比例する電界(E) を与えるため、立方晶KTNにおいては図1(b)に示すように電界 の2乗(xの2乗)に比例した屈折率分布が生じる。特に入力偏 波が電界に平行な場合大きな屈折率分布が生じる。

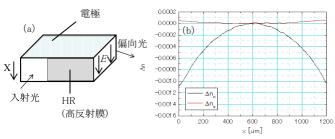


図 1 (a) KTN 光スキャナの構造 (b) 残留電荷による結晶厚 方向の屈折率変化($\angle n_v$ は電界 $//偏波、<math>\angle n_v$ は電界 \perp 偏波)

従って、電圧印加後の KTN 結晶の屈折率分布は GRIN レン ズと同等で、屈折率分布および光線行列は結晶中心を原点とし た時下式で与えられる。ただし、 $A_0 = n_0^2 g_{11} \rho^2$ である。

$$\mathbf{n}(x) = \mathbf{n}_0 \{ 1 - (1/2) n_0^2 g_{11}^2 \rho^2 [x + (\varepsilon/\rho) \cdot (V/d)]^2 \}$$
 (2)

$$\begin{bmatrix} cos(\sqrt{A_0}L) & (1/n_0\sqrt{A_0})sin(\sqrt{A_0}L) \\ -n_0\sqrt{A_0}sin(\sqrt{A_0}L) & cos(\sqrt{A_0}L) \end{bmatrix}$$
(3)

KTN 結晶にVの電圧を印加した場合、式2によれば、レン ズの中心が $(\varepsilon/\rho)\cdot(V/d)$ だけずれることに相当し、x=0と なる位置に光を垂直入射し、電圧Vを印加した時の入射光の 状態を表すベクトルは下式で与えらえる。

$$\begin{bmatrix} (\varepsilon/\rho) \cdot (V/d) \\ 0 \end{bmatrix} \tag{4}$$

従って、交流電界を印加した場合、peak to peak の電圧差を ΔV とすれば偏向角 θ は下式で与えられる。

$$\theta = -n_0^2 \sqrt{g_{11}} \varepsilon (\Delta V/d) sin(n_0 \sqrt{g_{11}} \rho L)$$
 (5)

3. 実験および結果

同一の KTN スキャナに対し入射角度を変え内部反射型の3 パス、5 パス、7 パスの光路を構成し、印加電圧ΔV=400V、入射 波長 1.3 μm、印加電圧周波数が 200 kHz にて偏向角を測定し た。図2に図1(a)を電極方向から見た時の各光路の様子を示す。 チップ面積は、3.2X4 mm²で、光路長は3パスが12.2 mm、5パ スが 20.1 mm、7 パスが 28.0 mm となった。

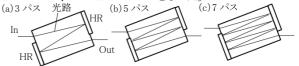


図 2 KTN光スキャナの折り返し構成(偏向方向は紙面垂直)

なお、実験に用いたKTN結晶では、 $n_0=2.18$ 、 $g_{11}=0.11$ m⁴/C²、 ρ=75C/m³であった。 図 3 に測定結果および式 1、式 5 に基く偏 向角の様子を示す。測定値はレンズ効果を考慮した式5で説明 でき、光路長を伸長しても偏向角増大には限界があることが確 認できた。

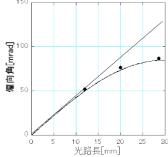


図 3 偏向角の光路長依存性

(黒丸は実測値、実線は式5、点線は式1に基く偏向角)

4. まとめ

今回我々は折り返し数を増やし光路長を制御した KTN 光ス キャナの偏向角特性を調べた。実験で得られた偏向角は GRIN レンズ効果を考慮したモデルで解釈でき、偏向角は光路長に 対して飽和することが分かった。

参考文献

- [1] Y. Okabe et al, '200 kHz swept light source equipped with KTN deflector for optical
- coherence tomography', Electron. Lett., 2012, **48**, pp. 201-202. [2] J. Miyazu et al, 'New beam scanning model for high-speed operation using KTa_{1-x}Nb_xO₃ crystals', Appl. Phys. Exp. 2011, 4, pp.111501-1-3.